# Исследование порога Оже-процессов в гетероструктурах с КЯ $Hg_x Cd_{1-x} Te$ .

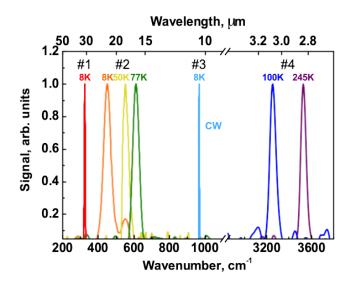
Выполнил: Куликов Н.С.

Научный руководитель: Морозов С.В.

ифм ран

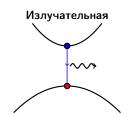
2019

Было получено стимулированное излучение на длинах волн  $\sim$  30  $\mu m$  в структурах HgCdTe при T= 8 K.

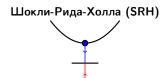


Можно ли поднять рабочую температуру?

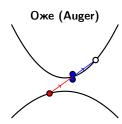
## Типы рекомбинации



Целевой процесс - нужно только усиливать, а остальное - подавлять.



Происходит с участием примесей.  $\Rightarrow$  В чистых материалах - нет.



Пороговый эффект.  $\Rightarrow$  Можно повысить порог, тем самым подавив процесс.

# Порог Оже-рекомбинации

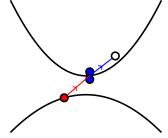
В этом процессе участвует 3
частицы. Для такого процесса
должны выполняться законы
сохранения энергии, импульса. ⇒
Это возможно только для
определённых состояний системы,
что объясняет наличие порога.

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 + \vec{k}_2 - \vec{k}_3 &= \vec{k}_f; \\ \varepsilon_1(\vec{k}_1) + \varepsilon_2(\vec{k}_2) - \varepsilon_3(\vec{k}_3) &= \varepsilon_f(\vec{k}_f); \end{aligned}$$

Здесь  $\vec{k_i}$ ,  $\varepsilon_i$ : i=1,2,3 - начальные импульсы частиц и соответствующие им ветви дисперсионного соотношения, индекс f - конечному состоянию.

#### • Минимальная

"кинетическая"энергия носителей заряда, при которой возможны такие процессы - пороговая энергия  $\varepsilon_{th}$ .



Невозможный процесс.

## Порог Оже-рекомбинации

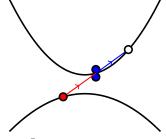
 В этом процессе участвует 3 частицы. Для такого процесса должны выполняться законы сохранения энергии, импульса. ⇒ Это возможно только для определённых состояний системы, что объясняет наличие порога.

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 + \vec{k}_2 - \vec{k}_3 &= \vec{k}_f; \\ \varepsilon_1(\vec{k}_1) + \varepsilon_2(\vec{k}_2) - \varepsilon_3(\vec{k}_3) &= \varepsilon_f(\vec{k}_f); \end{aligned}$$

Здесь  $\vec{k_i}$ ,  $\varepsilon_i$ : i=1,2,3 - начальные импульсы частиц и соответствующие им ветви дисперсионного соотношения, индекс f - конечному состоянию.

#### • Минимальная

"кинетическая"энергия носителей заряда, при которой возможны такие процессы - пороговая энергия  $\varepsilon_{th}$ .



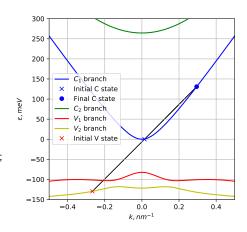
Возможный процесс.

# Как найти порог Оже-процессов?

- Дисперсионные соотношения в HgCdTe получаются в модели Кейна 8x8.
- Требуется минимизировать для каждой 4-ки начальных и конечных состояний функцию, характеризующую "кинетическую"добавку с учётом сохранения энергии:

$$K(\vec{k}_1, \vec{k}_2, \vec{k}_3) = \varepsilon_f(\vec{k}_1 + \vec{k}_2 - \vec{k}_3) - \beta \varepsilon_g;$$

 При этом, начальные и конечные состояния могут быть на разных ветвях - матричные элементы перехода не равны нулю.



## Сравнение с экспериментом 14 $\mu m$

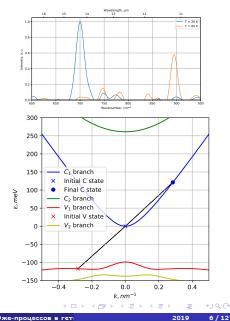
При сопоставлении экспериментальных данных и теоретических расчетов порога была получена эмпирическая формула связи критической для стимулированного излучения температуры и пороговой энергии:

$$T_{cr} pprox arepsilon_{th}/2;$$

Для её демонстрации была выбрана структура состава

 $Hg_{0.903}Cd_{0.097}Te/Cd_{0.7}Hg_{0.3}Te$ , имеющая 10 квантовых ям толщиной 7.4 пт. Было получено СИ в диапазоне  $11 - 14 \ \mu m$  при температурах 18 - 85 K.

Искомый процесс имеет тип ССНС и при T=80~K соответственно  $\varepsilon_{\rm g}=99~meV$ , пороговая энергия  $\varepsilon_{th} \approx 18.4 \; meV$ , это соответствует  $T_{cr} \approx 100~K$ .

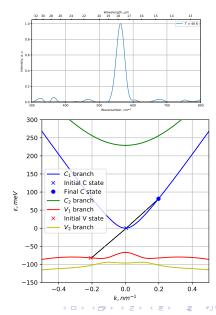


## Сравнение с экспериментом 18 $\mu m$

Аналогично для структуры, расчитанной на длину волны  $18~\mu m$ :

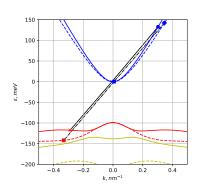
 $Hg_{0.9}Cd_{0.1}Te/Cd_{0.65}Hg_{0.35}Te$ , имеющая 10 квантовых ям толщиной 8.7 nm. Было получено СИ в диапазоне 18  $\mu m$  при температуре 50 K.

Искомый процесс имеет тип ССНС и при T=40~K соответственно  $\varepsilon_{\rm g}=67~meV$ , пороговая энергия  $\varepsilon_{\rm th}\approx 15~meV$ , это соответствует  $T_{cr}\approx 80~K$ .



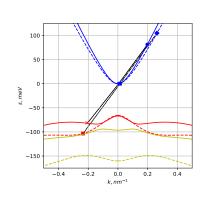
## Влияние наличия Cd внутри КЯ







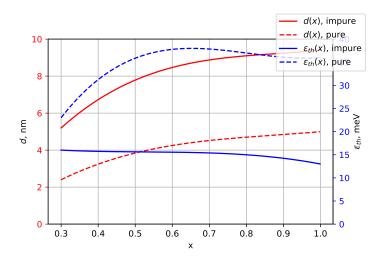
#### $\lambda \approx 18 \ \mu m$



Можно видеть разницу в пороговых энергиях для обоих структур. Она обусловлена наличием или отсутствием боковых максимумов. 4 □ > 4 □ > 4 □ > 4 □ >

8 / 12

#### Порог оже-рекомбинации vs. состав барьера



Как можно видеть, существует значительный максимум  $arepsilon_{th}$  при составе барьера  $Hg_{0.33}Cd_{0.67}$  Те. Аналогичные расчёты можно провести и для других структур.

#### Выводы и перспективы.

- При сравнении экспериментально полученной критической температуры с рассчитанным порогом оже-процессов наблюдается эмпирическая закономерность  $T_{cr} \approx \varepsilon_{th}/2$ .
- При фиксированной величине ширины запрещённой зоны, увеличение концентрации кадмия в ямах ведёт к снижению порога.
- При фиксированной величине запрещённой зоны максимальная величина порога наблюдается при концентрации кадмия в барьерах 0.55-0.65.

## Литература I

- [1] Vladimir Rumyantsev, Mikhail Fadeev, Vladimir Aleshkin, Nikita Kulikov, Vladimir Utochkin, Nikolai Mikhailov, Sergey Dvoretskii, Sergey Pavlov, Heinz-Wilhelm Hübers, Vladimir Gavrilenko, et al. Carrier recombination, long-wavelength photoluminescence, and stimulated emission in hgcdte quantum well heterostructures. *physica status solidi (b)*, page 1800546, 2019.
- [2] VV Rumyantsev, NS Kulikov, AM Kadykov, MS Zholudev, MA Fadeev, V Ya Aleshkin, S Winnerl, NN Mikhailov, SA Dvoretskii, VI Gavrilenko, et al. Hgcdte based quantum well heterostructures for long-wavelength lasers operating in 5-15 thz range. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1092, page 012126. IOP Publishing, 2018.
- [3] Дмитрий Владимирович Козлов, В В Румянцев, Н С Куликов, А М Кадыков, М А Фадеев, В В Уточкин, Н Н Михайлов, С А Дворецкий, В И Гавриленко, Г В Хьюберс, et al. Особенности фотолюминесценции двойных акцепторов в гетероструктурах hgte/Cdhgte с квантовыми ямами в терагерцовом диапазоне. Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики, 109(10):679–684, 2019.

## Литература II

- [4] В.В. Румянцев, Н.С. Куликов, А.М. Кадыков, Фадеев, А.В. М.А., Иконников, А.С. Казаков, М.С. Жолудев, В.Я. Алешкин, В.В. Уточкин, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, С.В. Морозов, and В.И. Гавриленко. Влияние особенностей зонного спектра на характеристики стимулированного излучения в узкозонных гетероструктурах с квантовыми ямами на основе hgcdte. *Физика и техника полупроводников*, 52:1263, 2018.
- [5] В.В. Уточкин, В.Я. Алёшкин, Н.С. Куликов, А.А. Дубинов, В.И. Гавриленко, М.А. Фадеев, В.В. Румянцев, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, and С.В. Морозов. Исследование пороговой энергии оже-рекомбинации в волноводных структурах с квантовыми ямами hgte/cd0.7hg0.3te в области 14 мкм. Физика и техника полупроводников, 2019.